

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 1 月 12 日 (2006.1.12)

【公開番号】特開 2001-257139(P2001-257139A)
 【公開日】平成 13 年 9 月 21 日 (2001.9.21)
 【出願番号】特願 2001-633(P2001-633)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/02 A

H 0 1 L 21/02 B

H 0 1 L 27/12 B

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 11 月 21 日 (2005.11.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体基板

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 支持基板の上方に貼り合せによって設けられた半導体層を有する半導体基板において、前記支持基板の周辺領域の傾斜面に、マークが形成されていることを特徴とする半導体基板。

【請求項 2】 前記マークは数字、文字、記号、バーコードからなる群から選択される少なくとも一種である請求項 1 記載の半導体基板。

【請求項 3】 前記マークは、ノッチ又はオリエンテーションフラットの近傍にある請求項 1 記載の半導体基板。

【請求項 4】 前記マークは、前記領域の表面に形成された凹部及び / 又は凸部から形成されている請求項 1 記載の半導体基板。

【請求項 5】 前記マークは、レーザ光により形成されたものである請求項 1 記載の半導体基板。

【請求項 6】 前記半導体基板は、前記支持基板と前記半導体層との間に絶縁層を有する請求項 1 記載の半導体基板。

【請求項 7】 前記半導体基板は、水素及び / 又は不活性ガスのイオン注入層において分離された前記半導体層を有する請求項 1 記載の半導体基板。

【請求項 8】 前記半導体基板は、多孔質体上に形成された非多孔質半導体層を前記支持基板に移設して形成された前記半導体層を有する請求項 1 記載の半導体基板。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

本発明は、支持基板の上方に貼り合せによって設けられた半導体層を有する半導体基板において、前記支持基板の周辺領域の傾斜面に、マークが形成されていることを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】削除

【補正の内容】